

## مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Y(Nd)-1۲۳ با آلایش‌های CaTh و La بر اساس مدل جفت‌پلارونی

شعبان رضا قربانی و ابراهیم رستم‌آبادی

گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار

(دریافت مقاله: ۸۶/۵/۲؛ دریافت نسخه نهایی: ۸۶/۸/۲۳)

### چکیده

ترکیبات بس‌بلور ابررسانای  $NdBa_{\gamma-x}La_xCu_xO_{7-\delta}$  و  $Y_{1-x}Ca_xTh_xBa_xCu_xO_{7-\delta}$  به روش استاندارد حالت جامد ساخته شده‌اند. خواص تراپریدی و ابررسانایی آنها با اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش CaTh در بازه  $0^{\circ}\text{C} \leq x \leq 0.75$  و  $0^{\circ}\text{C} \leq T \leq 0.3^{\circ}\text{C}$  مطالعه شده است. برای تحلیل داده‌های تجربی از مدل پدیده شناختی جفت‌پلارونی استفاده شد. مدل جفت‌پلارونی مقاومت الکتریکی را تا نزدیکی دمای بحرانی به خوبی توصیف می‌کند. نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌کند جایگزینی حاملها علت اصلی در ازین رفتن ابررسانایی در ابررساناهای کوپرات آلاییده با آلایش خنثی از لحاظ الکتریکی و یکی از عوامل اصلی در ابرسانایی آلاییده شده پایه Nd با La، علاوه بر پرکردن حفره‌ها، است.

واژه‌های کلیدی: ابررسانایی، آلایش، مدل جفت‌پلارونی

### ۱. مقدمه

الکتریکی است [۱]. اما چون مقاومت الکتریکی این ابررساناهای از دمای اتفاق تا دمای افت و خیزهای ابررسانایی (اندکی بالاتر از دمای بحرانی ابررسانایی) به صورت خطی با دما تغییر می‌کند اثری از شبه گاف مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر علت کاهش خاصیت ابررسانایی در ابررساناهای  $YBa_{\gamma-x}La_xCu_xO_{7-\delta}$  پرشدن حفره‌ها توسط الکترون اضافه شده به وسیله آلایش La عنوان شده است [۲ و ۳]. لذا افزایش آلایش La باعث کاهش بیشتر چگالی حاملهای بار و رفتن به ناحیه کمتر آلاییده شده از حد بهینه (underdoped) و بازشدن شبه گاف می‌گردد. سؤال این است که آیا تنها پرشدن حفره‌ها توسط الکترونها عامل ازین رفتن ابررسانایی در بس‌بلور  $YBa_{\gamma-x}La_xCu_xO_{7-\delta}$  است؟ مدل‌های زیادی تا به حال برای توضیح حالت ابررسانایی

علی‌رغم فعالیتهای زیادی که در طی سالهای اخیر در زمینه ابررساناهای دمای بالا صورت گرفته است، اما هنوز نظریه کاملی برای توصیف سازوکار ابررسانایی در ابررساناهای دمای بالا وجود ندارد و همچنان به عنوان یک چالش در فیزیک ماده چگال باقیمانده است. مقاومت الکتریکی عموماً آسان‌ترین و سر راست‌ترین روش برای به دست آوردن اطلاعات مفیدی درباره کیفیت نمونه، خواص حالت عادی، دمای شبه گاف،  $T_c$  (دمایی که در آن یک گاف در چگالی حالت‌های الکترونی باز می‌شود)، و دمای بحرانی حالت ابررسانایی است.

کاهش چگالی حاملهای بار (حفره‌ها) توسط جایگزینی شدن یکی از دلایل کاهش خاصیت ابررسانایی در بس‌بلورهای RE-1۲۳ (عناصر خاکی نادر=RE) آلاییده شده خنثی از لحاظ

## ۲. آزمایش

نمونه‌های  $\text{Y}_{1-2x}\text{Ca}_x\text{Th}_x\text{Ba}_y\text{Cu}_z\text{O}_{7-\delta}$  و  $\text{NdBa}_{2-x}\text{La}_x\text{Cu}_z\text{O}_{7-\delta}$  به ترتیب با آلایش‌های در بازه  $x=0.075 \leq x \leq 0.30$  و  $x=0.00 \leq x \leq 0.05$  به روش پودر حالت جامد ساخته شده‌اند. جهت ساخت نمونه‌ها پودر مواد اولیه  $\text{CuO}$ ,  $\text{La}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{Th}_2\text{O}_3$ ,  $\text{BaCO}_3$ ,  $\text{Nd}_2\text{O}_3$  خلوص بیش از ۹۹٪ ابتدا با ترازوی دیجیتالی (با دقت ۱/۱۰۰۰۰ گرم) وزن و سپس با دقت با هم مخلوط شدن. نمونه‌ها به صورت قرص سه بار به ترتیب در دماهای ۹۰۰، ۹۲۰، ۹۴۰°C پخت شدند. در بین مراحل پخت قرصها آسیاب می‌شدند. برای بهینه کردن مقدار اکسیژن، نمونه‌ها در حضور اکسیژن به مدت ۳ روز در دمای ۴۶۰°C باز پخت شده و سپس با آهنگ  $12^{\circ}\text{C}/\text{hr}$  تا دمای اتاق سرد شدند.

اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از ترکیب ۴ سوزنی استاندارد انجام گردید. برای اتصال الکتریکی از چسب نقره به صورت نوار باریک روی نمونه‌ها استفاده شد. به منظور بهبود مقاومت الکتریکی اتصال، نمونه‌ها در اتمسفر اکسیژن به مدت نیم ساعت در دمای  $300^{\circ}\text{C}$  باز پخت و سپس سریعاً تا دمای اتاق سرد گردید. در نهایت توسط چسب نقره سیم نازک مسی به نقطه اتصال وصل شد. با این روش مقاومت الکتریکی  $\Omega$  در محل اتصال به دست آمد که مقدار مناسبی جهت اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی است.

نتایج پراش به روش پودر اشعه X برای سری  $\text{NdBa}_{2-x}\text{La}_x\text{Cu}_z\text{O}_{7-\delta}$  [۱۶] و پراش به روش پودر نوترون [۱۷] نشان داد که تمام نمونه‌ها، به جز نمونه  $x=0.075$  (حد حلالیت آلایش  $\text{CaTh}$  در کوپراتها) در آلایش  $\text{CaTh}$  که در آن چند پیک ناخالصی مشاهده شده، تک فاز و دارای ساختار راست گوشه هستند.

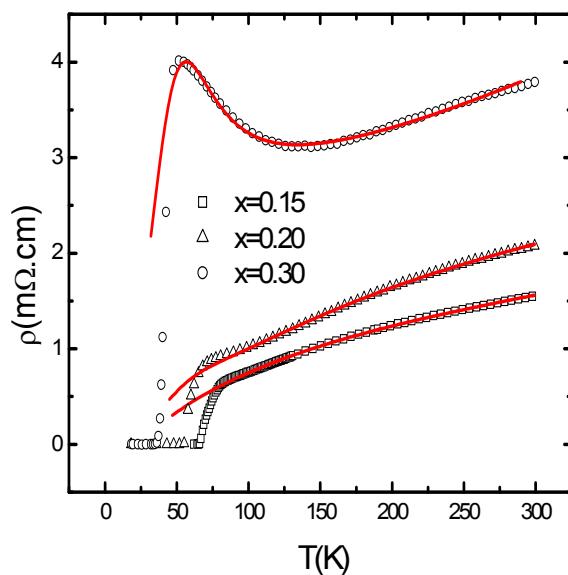
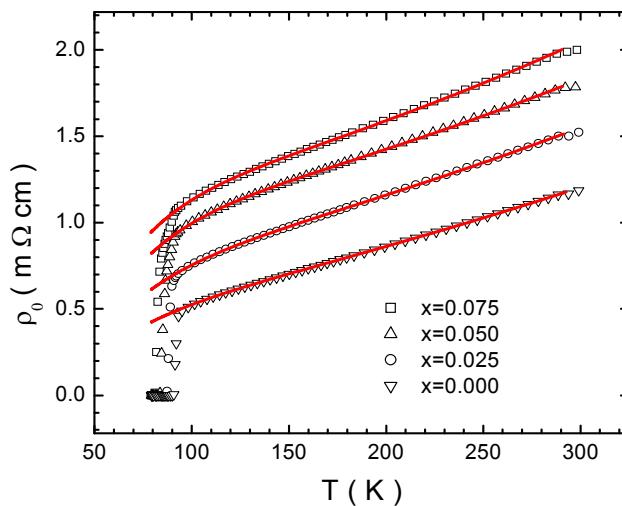
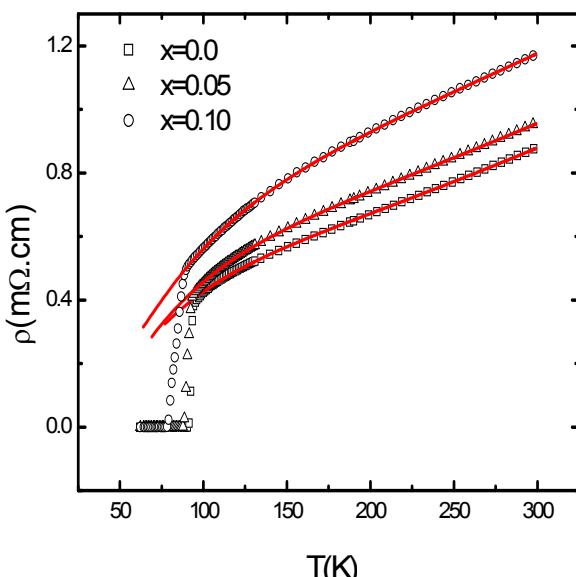
## ۳. نتایج و تحلیل داده‌ها

### ۳.۱. ترکیب $\text{Y}_{1-2x}\text{Ca}_x\text{Th}_x\text{Ba}_y\text{Cu}_z\text{O}_{7-\delta}$

نتایج اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بس‌بلور  $\text{Y}_{1-2x}\text{Ca}_x\text{Th}_x\text{Ba}_y\text{Cu}_z\text{O}_{7-\delta}$  به صورت تابعی از دما و غلاظت

بیان گردیده‌اند. مدل جفت پلارونی یکی از این مدل‌ها است. مات پیشنهاد کرد در صورتی که حاملها به صورت جفت پلارونی‌های اسپینی در یک شبکه دو بعدی در نظر گرفته شوند [۴]، وابستگی خطی مقاومت الکتریکی ابررساناهای کوپرات آلاییده شده به طور بهینه (optimally doped) بر حسب دما در گستره دمایی اندکی بالاتر از دمای بحرانی تا دماهایی از مرتبه  $K = 1000$  خواهد بود [۵]. این مدل با در نظر گرفتن جایگزیدگی حاملها توسط بی‌نظمیها مقاومت الکتریکی ترکیبات  $\text{RE}-123$  را توصیف می‌کند [۶]. یکی از ویژگی‌های برجسته مدل جفت پلارونی توصیف وابستگی غیر خطی مقاومت الکتریکی صفحات  $\text{CuO}_2$  ابررساناهای آلاییده شده با آلایش کمتر از حد بهینه در دماهای پایین‌تر از دمای شبکه گاف و تعیین چگالی حاملهای بار جایگزیده شده از روی پارامترهای برازشی است. در طی چند سال اخیر نتایج تجربی زیادی در چارچوب مدل جفت پلارونی توضیح داده شده است؛ بعضی از نتایج عبارتند از: مقاومت الکتریکی [۷-۹]، اثر رامان [۱۰]، طیف‌سنجی تونل‌زنی [۱۱]، اثر ایزوتوبی [۱۲]، میدان بحرانی بالای و گرمای ویژه غیر عادی [۱۳].

نکته شروع این مقاله این سؤال است که آیا این مدل می‌تواند در درک نحوه کاهش چگالی حاملهای بار ابررساناهای آلاییده شده توسط آلاینده‌های ختشی از لحظه الکتریکی مفید باشد و انحراف از وابستگی خطی مقاومت الکتریکی در دمای شبکه گاف و در نتیجه از بین رفتن ابررسانایی را توضیح دهد. لذا در این مقاله مقاومت الکتریکی و  $\text{Y}_{1-2x}\text{Ca}_x\text{Th}_x\text{Ba}_y\text{Cu}_z\text{O}_{7-\delta}$  حالت عادی بس‌بلورهای  $\text{NdBa}_{2-x}\text{La}_x\text{Cu}_z\text{O}_{7-\delta}$  به صورت تابعی از دما و آلایش اندازه‌گیری و از مدل جفت پلارونی [۱۴ و ۱۵] برای تحلیل داده‌ها استفاده شده و از روی پارامترهای برازشی به دست آمده چگالی حاملهای جایگزیده شده محاسبه می‌شود. این مدل داده‌های تجربی مقاومت الکتریکی در حالت عادی را در یک گستره بزرگ دمایی از دماهای نزدیک به دمای بحرانی تا دماهای خیلی بزرگتر از دمای اتاق (حدود  $K = 1000$ ) به خوبی توصیف می‌کند.



شکل ۲. مقاومت الکتریکی بس بلور  $NdBa_{2-x}La_xCu_2O_{7-\delta}$  به صورت تابعی از دما و آلایش. خطوط توپر برآش دادهای تجربی مقاومت الکتریکی به مدل جفت پلارونی معادله (۱).

الکتریکی با کاهش دما افزایش یافته و خاصیت نیمرسانایی از خود نشان می‌دهد  $\frac{d\rho}{dT} < 0$  است.

#### ۴. مدل جفت پلارونی

مدل جفت پلارونی توجه ویژه‌ای به برهم‌کنش قوی الکترون-فونون در ابرسانانهای دمای بالا دارد. مات و کساندروف بر اساس جفت پلارونها مدل ساده‌ای را

شکل ۱. داده‌های اندازه‌گیری شده مقاومت الکتریکی  $Y_{1-x}Ca_xTh_xBa_2Cu_2O_{7-\delta}$  به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش. خطوط توپر برآش دادهای تجربی بر اساس مدل جفت پلارونی (رابطه ۱) است.

آلایش در شکل ۱ نشان داده شده است. داده‌های تجربی نشان می‌دهند که با افزایش غلظت آلایش مقاومت ویژه الکتریکی بس بلور افزایش می‌یابد که نشان دهنده کاهش خاصیت فلزی نمونه‌ها با افزایش غلظت  $CaTh$  است. مقاومت الکتریکی نمونه‌ها در بازه دمایی  $T_c$  تا  $300\text{ K}$  وابستگی خطی نسبت به دما دارند، به جز در غلظت  $x = 0.075$  که به علت فاز ناخالصی یک گذار دو پله‌ای در نزدیکی دمای بحرانی مشاهده می‌شود که با نتایج حاصل از پراش نوترون [۱۷] در توافق است.

#### ۲.۳. ترکیب $NdBa_{2-x}La_xCu_2O_{7-\delta}$

مقاومت الکتریکی بس بلور  $NdBa_{2-x}La_xCu_2O_{7-\delta}$  به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش در بازه  $0 \leq x \leq 0.30$  در شکل ۲ نشان داده شده است. با افزایش غلظت آلایش مقاومت الکتریکی افزایش می‌یابد که نشان دهنده کاهش مقاومت فلزی نمونه‌ها است. با کاهش دما رفتار مقاومت الکتریکی نمونه‌ها از دمای  $K^*$  تا  $300\text{ K}$  به صورت خطی کاهش می‌یابد. در دمای شبکه‌گاف انحرافی از حالت همراه با کاهش مقاومت مشاهده می‌شود. مقاومت الکتریکی نمونه‌های  $0 \leq x \leq 0.20$  در بازه دمایی  $T_c$  تا  $T^*$  کاهش می‌یابد در حالی که برای نمونه  $x = 0.3$  مقاومت

درستی از هم تشخیص داد.

پارامتر  $T_l$ ، که نشان دهنده نسبت پراکندگی ناشی از فونونهای نوری به جفت پلارونها است، نیز با افزایش غلظت آلایش تا  $x=0.050$  افزایش یافته اما در  $x=0.075$  کاهش اندکی می‌یابد. کاهش پارامتر  $T_l$ ، به عبارت دیگر تغییر سهم آهنگ پراکندگی ناشی از منابع مختلف، در غلظت آلایش  $x=0.075$  ممکن است ناشی از وجود فاز ناخالصی باشد چون در طیف پراش نوترون مربوط به نمونه فوق چند پیک ناخالصی مشاهده شده است [۱۷] که نشان دهنده حد حلالیت حالت جامد آلاینده  $\text{CaTh}$  است. تغییرات نسبت جرم مؤثر جفت‌پلارونها به جرم پلارونها،  $A$ ، نیز تفاوت بین آلایش  $x=0.075$  و بقیه آلایشها (به جز  $x=0.0$ ) را نشان می‌دهد که در آن آهنگ افزایش جرم جفت‌پلارونها نسبت به جرم پلارونها در  $x=0.075$  افزایش یافته است.

ترکیبات  $\text{Y}_{1-x}\text{Ba}_x\text{Th}_x\text{Cu}_2\text{O}_{7-\delta}$  از لحاظ الکتریکی خنثی هستند. چون اضافه کردن حفره توسط  $\text{Ca}$  با اضافه کردن الکترون توسط  $\text{Th}$  جبران می‌شود. لذا این سؤال مطرح می‌شود که چرا مقاومت الکتریکی افزایش می‌یابد؟ حضور بی‌نظمیهای ناشی از آلایش در داخل یک شبکه دوره‌ای سبب تغییر ارتفاع سد پتانسیل به طور تصادفی می‌شود. این تغییرات باعث ایجاد حالت‌های جایگزینیه در انتهای نوار هدایت در زیر لبه‌های تحرک<sup>۱</sup>، که حالت‌های جایگزینیه را از حالت‌های گسترده جدا می‌کند، می‌شود [۲۰]. با افزایش چگالی آلایش سطح فرمی به طرف حالت‌های جایگزینیه در نوار هدایت جایه‌جا می‌شود که در توافق با افزایش مقاومت الکتریکی است. حتی در صورت افزایش بیشتر آلایش، سرانجام سطح فرمی به داخل قسمتهای جایگزینیه وارد شده و تمام حاملهای بار جایگزینیه می‌گردند لذا هدایت الکتریکی سریعاً کاهش می‌یابد.

طبق نتایج جدول ۱، پارامتر  $\rho$  با افزایش آلایش افزایش می‌یابد که نشان دهنده افزایش مقاومت ویژه الکتریکی است. از طرفی چون این پارامتر متناسب با عکس تراکم حاملهای

برای کوپراتها ارائه دادند [۱۸]. در این مدل جفت‌پلارونها در اثر برهم‌کنش پلارونها (حفره‌ها) با فونونهای اپتیکی تشکیل می‌شوند و نوع حاملها در حالت‌های عادی و ابررسانایی تغییر نمی‌کند. حالت ابررسانایی بر اثر چگالش بوز-انیشتین جفت‌پلارونهای باردار، با بار الکتریکی  $2e$ ، رخ می‌دهد [۱۹] و پراکندگیهای مؤثر بوزون-بوزون و بوزون-فونون نوری عامل کاهش رسانایی در حالت عادی هستند. بر اساس این مدل مقاومت ویژه الکتریکی در صفحات  $\text{CuO}_2$  به صورت زیر است [۱۵]:

$$\rho = \rho_0 \frac{(T/T_l)^{\gamma} + \exp(-\omega/T)}{[1 + A(T/T_c)y^{\gamma} \exp(-T^*/T)]}, \quad (1)$$

که در آن

$$\begin{aligned} \rho_0 &= \frac{bm_b}{4\epsilon^2(x - n_L)}, & T_l &= (b/a)^{1/2}, \\ A &= (m_b/m_P)^{5/2}, & \tau^{-1} &= aT^2 + b\exp(-\omega/T), \\ y &= 1 - \exp(-T_c/T), & T_c &= \pi(x - n_L)/m_b \approx T_C, \end{aligned}$$

و  $m_p$  و  $m_b$  به ترتیب جرم جفت‌پلارون و پلارون،  $T^*$  دمای شبه‌گاف،  $\omega$  انرژی فونون نوری است.  $a$  ضریب پراکندگی غیرکشسان حاملهای بار توسط حاملهای جایگزینیه شده (بوزونها) و  $b$  ضریب پراکندگی توسط فونونهای نوری است. این پراکندگیها باعث کاهش زمان واهلش و در نتیجه افزایش مقاومت الکتریکی می‌شوند.  $n_L$  تراکم حاملهای جایگزینیه شده توسط بی‌نظمی در سلول واحد هستند.

#### ۴.۱. تحلیل داده‌های تجربی بر اساس مدل جفت‌پلارونی

##### ترکیب $\text{Y}_{1-x}\text{Ca}_x\text{Th}_x\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$

داده‌های تجربی مقاومت الکتریکی به مدل جفت‌پلارونی رابطه (۱) برآورده شدند که در شکل ۱ با خطوط توپر نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود مدل به خوبی داده‌های تجربی را تا نزدیکی دمای بحرانی توصیف می‌کند. پارامترهای به دست آمده از برآذش در جدول ۱ آورده شده‌اند. در برآذش داده‌های مقاومت الکتریکی به مدل جفت‌پلارونی دمای شبه‌گاف برابر دمای افت و خیزهای ابررسانایی انتخاب شده است ( $T^* = 110^\circ\text{C}$ )، چون در دمای نزدیک به دمای بحرانی نمی‌توان دو دمای فوق را به

<sup>۱</sup>. Mobility edges

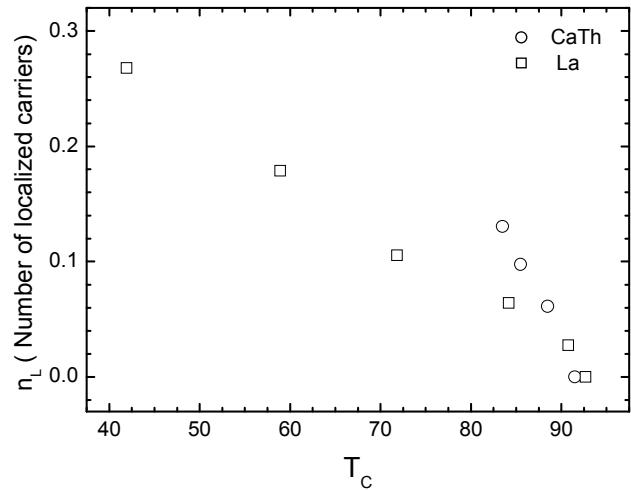
جدول ۱. پارامترهای به دست آمده از برآش داده‌های تجربی به مدل جفت‌پلارونی برای  $Y_{1-x}Ca_xTh_xBa_7Cu_7O_{7-\delta}$ .

$x$	$\rho_0$	$T_l$	$\omega$	$A$
۰,۰۰	۵,۱۴۹۴	۲۰۲,۹۴۹۴۴	۲۲۲,۰۳۸۷۷	۹,۰۷۹۹۹
۰,۰۲۵	۷,۷۸۴۵۲	۲۴۱,۵۹۹۵۳	۱۹۷,۱۰۶۳۸	۸,۰۱۹۵۷
۰,۰۵۰	۱۶,۲۶۵۰۲	۲۸۵,۹۴۱۹۶	۲۰۲,۱۳۳۹۷	۱۱,۲۲۳۶۳
۰,۰۷۵	۲۴,۸۸۱۰۱	۲۸۰,۱۴۸۳۷	۲۰۸,۲۸۷۳۸	۱۵,۸۳۲۲۳

#### ۲.۴. ترکیب $NdBa_{2-x}La_xCu_7O_{7-\delta}$

داده‌های تجربی مقاومت الکتریکی به مدل جفت‌پلارونی رابطه (۱) برآیده شدند که در شکل ۲ با خطوط توپر نشان داده شده است. مدل به خوبی داده‌های تجربی را تا نزدیکی دمای بحرانی توصیف می‌کند. پارامترهای به دست آمده از برآش در جدول ۲ آورده شده‌اند. همان طوری که در جدول ۲ دیده می‌شود با افزایش آلایش پارامتر  $\rho_0$  افزایش می‌یابد که بیانگر افزایش مقاومت الکتریکی است. با افزایش مقاومت الکتریکی، رسانندگی و در نتیجه خاصیت فلزی نمونه‌ها کاهش می‌یابد. پارامتر  $T_l$  و  $\omega$  نیز با افزایش آلایش تا  $x=0.2$  افزایش می‌یابد در حالی که برای  $x=0.3$  کاهش می‌یابد. پارامتر  $T_l$  نشان دهنده نسبت پراکندگیها توسط فونونها و جفت‌پلارونها است. در  $x=0.2$  پراکندگی فونونها نسبت به پراکندگی بوزونها مؤثرتر است بنابراین باعث کاهش  $T_l$  می‌شود. پارامتر  $A$  نسبت جرم جفت‌پلارونها به پلارونها را نشان می‌دهد. تغییرات نسبت جرمها به غلظت آلایش به صورت خطی است به جز در  $x=0.3$  که از حالت خطی منحرف می‌شود.

در ترکیبات  $NdBa_{2-x}La_xCu_7O_{7-\delta}$  با جانشانی آلایش  $CuO_2$  به جای  $Ba^{2+}$  یک الکترون اضافی به صفحات  $La^{3+}$  افزوده می‌گردد که باعث خنثی شدن حفره‌ها خواهد شد. با استفاده از پارامترهای برآشی تراکم حاملهای جایگزیده محاسبه شده است که نتایج حاصل از آن در شکل ۳ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود با افزایش غلظت آلایش تراکم حاملهای جایگزیده افزایش می‌یابد. اما در

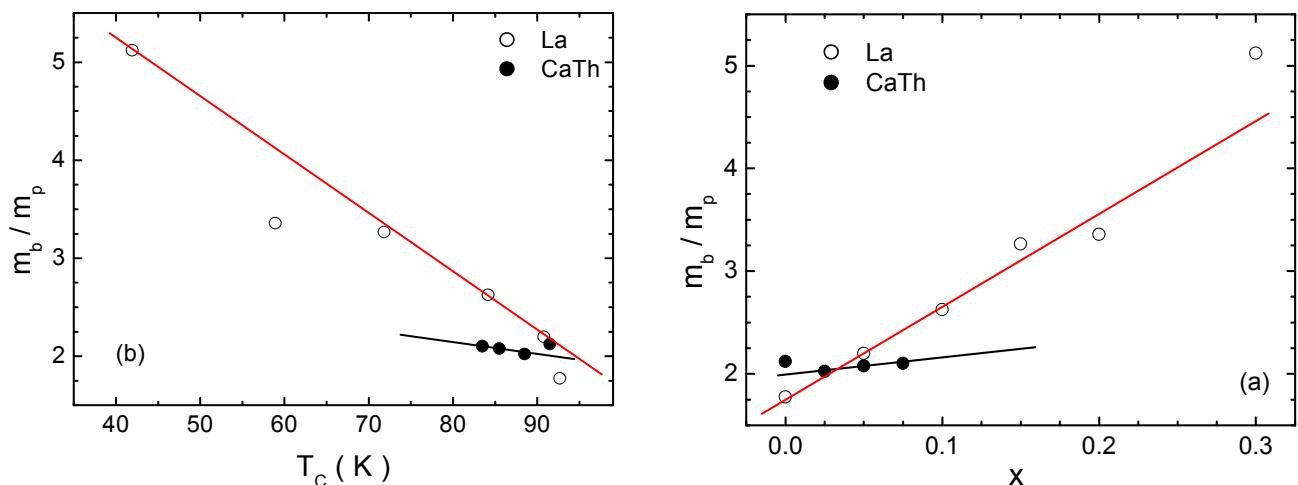


شکل ۳. غلظت حاملهای جایگزیده در سلول واحد در ترکیبات  $NdBa_{2-x}La_xCu_7O_{7-\delta}$  و  $Y_{1-x}Ca_xTh_xBa_7Cu_7O_{7-\delta}$  بر حسب دمای بحرانی.

جاگزیده  $n_L$  است لذا می‌توان با استفاده از پارامترهای برآشی تراکم حاملهای جایگزیده شده را محاسبه کرد. شکل ۳ تراکم حاملهای جایگزیده را بر حسب دمای بحرانی ابررسانایی  $T_c$  نشان می‌دهد. همان طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود با افزایش غلظت آلایش،  $T_c$  کاهش و چگالی حاملهای جایگزیده افزایش می‌یابد که در توافق با مدل جفت‌پلارونی جایگزیده شدن حاملهای بار توسط بی نظمیها است. بنابراین بر اساس مدل جفت‌پلارونی جایگزیده شدن حاملها علت کاهش خاصیت فلزی و از بین  $Y_{1-x}Ca_xTh_xBa_7Cu_7O_{7-\delta}$  در ترکیبات ابررسانایی است که با نتایج حاصل از برآش مدل نوار باریک به داده‌های توان گرما الکتریسیته [۲۱] توافق خوبی دارد.

جدول ۲. پارامترهای به دست آمده از برآورد مدل جفت‌پلارونی رابطه ۱ برای  $\text{NdBa}_{2-x}\text{La}_x\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 

$x$	$\rho_0$	$T_l$	$\omega$	$A$	$T^*$
۰,۰	۲,۹۷۰۴۷	۲۸۹,۷۶۳۷	۱۷۰,۳۶۲۱۷	۴,۱۹۴۲	۱۱۰,۶۲۹
۰,۰۵	۷,۰۴۳۶۵	۳۴۱,۸۶۳۷	۲۲۵,۹۷۵۶۸	۷,۱۶۸۰۴	۱۲۳,۲۲
۰,۱	۱۹,۴۸۰۰۱	۴۱۳,۴۲۵۹۳	۳۰۶,۹۲۵۴۶	۱۱,۱۶۲۲۳	۱۵۲,۲۹۰
۰,۱۵	۵۷,۳۸۷۹۶	۶۴۳,۹۰۹۷	۴۴۱,۹۴۹۰۸	۱۹,۲۵۰۱۲	۲۱۲,۷۸
۰,۲	۱۱۵,۱۲۸۵۱	۶۵۶,۵۳۲۸۷	۵۰۱,۲۹۰۰۸	۲۰,۶۴۳۸۳	۲۲۹,۶۹
۰,۳	۲۶۰,۶۴۳۳۷	۲۷۸,۹۶۶۸۴	۳۸۳,۱۵۰۳۶	۵۹,۳۱۶۷۴	۲۴۱,۴۴



شکل ۴. (a) تغییرات نسبت جرم جفت‌پلارونها به جرم پلارونها بر حسب دماهای بحرانی. (b) تغییرات نسبت جرم جفت‌پلارونها به جرم افزایش آلایش  $x$ .

از روی پارامترهای به دست آمده در جداول ۱ و ۲ نسبت جرم جفت‌پلارون به پلارون برای غلظتهای آلایش متفاوت در هر دو ترکیب محاسبه شد. نتایج به دست آمده در شکل ۴ نشان داده شده‌اند. مشاهده می‌شود که نسبت جرم جفت‌پلارونها با افزایش غلظت آلایش  $\text{CaTh}$  تقریباً ثابت است در حالی که با افزایش غلظت  $\text{La}$  شدیداً افزایش می‌یابد.

لذا مدل پیشنهاد می‌کند که آلایشهای خنثی، که تأثیر کمتری بر روی چگالی حاملهای صفحات  $\text{CuO}_2$  دارند، تغییرات نسبت جرم‌های کمتری هم نسبت به آلایشهای غیر خنثی دارند (شکل ۴). تغییر دمای بحرانی برای ترکیبات با آلایش غیر خنثی نیز نسبت به آلایشهای خنثی با تغییر غلظت آلایش بیشتر است.

$x=0,3$  آهنگ افزایش تراکم حاملهای جایگزیده اندکی کاهش می‌یابد، که با تحرک پیشتر جفت‌پلارونها توافق خوبی دارد. از روی شکل ۳ مشاهده می‌شود که با افزایش حاملهای جایگزیده دمای بحرانی نمونه‌ها کاهش می‌یابد. نتایج فوق نشان می‌دهند که آهنگ افزایش جایگزیدگی توسط  $\text{La}$  کمتر از  $\text{CaTh}$  است. دلیل آن است که  $\text{La}$  علاوه بر جایگزیدگی، تعدادی حفره نیز به شبکه اضافه می‌کند چون ظرفیت آن  $+3$  است در حالی که ظرفیت  $\text{Ba}$  برابر  $+2$  است. بنابراین علاوه بر پرکردن حفره‌ها توسط الکترونها اضافه شده به وسیله  $\text{La}$  جایگزیدگی حاملها نیز عامل دیگری جهت از بین رفتن ابررسانایی در این ترکیبات است.

[۲]. لذا برای برآورد مقدار آلایش بهینه La با توجه به دمای بحرانی [۲۲] و برآش خطی به نمودار نسبت جرمها بر حسب دمای بحرانی، مقدار بهینه  $1/874$  برای نسبت جرم جفت پلارونها و به پلارونها به دست آمد. با قرار دادن مقدار بهینه نسبت جرمها و برآش خطی، غلظت آلایش بهینه تقریباً برابر  $x_{opt} \approx 0.02$  برای آلایش La تعیین شد که توافق بسیار خوبی با نتایج به دست آمده برای  $YBa_{2-x}La_xCu_2O_{7-\delta}$  دارد [۳].

با توجه به نمودار فاز (دما-چگالی حاملهای بار در صفحات  $CuO_2$ ) ابرساناهای ۱۲۳-RE با  $0 \approx 8$  اندرکی در ناحیه بیشتر آلاییده از حد بهینه (overdoped) قرار دارند. بنابراین دمای بحرانی این نمونه‌ها کمتر از دمای بحرانی نمونه‌های آلاییده شده به صورت بهینه (optimally doped)، آلایشی که به ازای آن دمای بحرانی بیشینه است، می‌باشد [۳]. در حالی که بیشینه دمای بحرانی به دست آمده برای آلایش La برابر  $94.2$  K است

## مراجع

1. B Lundqvist, P Lundqvist and Ö Rapp, *Phys. Rev. B* **57** (1998) 14428.
  2. J J Neumeier and H A Zimmerman, *Phys. Rev. B* **47** (1993) 8385.
  3. J L Tallon and N E Flower, *Physica C* **204** (1993) 237.
  4. N F Mott, *Philos. Mag. Lett.* **52** (1990) 273.
  5. A S Alexandrov, *Physica C* **182** (1991) 327.
  6. A S Alexandrov and N F Mott, *Supercond. Sci. Technol.* **6** (1993) 215.
  7. A S Alexandrov, A M Bratkovsky and N F Mott, *Phys. Rev. Lett.* **72** (1994) 1734.
  8. X H Chen et al., *Phys. Rev. B* **58** (1998) 14 219.
  9. A S Alexandrov, V V Kabanov and N F Mott, *Phys. Rev. Lett.* **77** (1996) 4796.
  10. S Sugi, *Physica C* **76** (1991) 187-189.
  11. A S Alexandrov, *Physica C* **305** (1998) 46.
  12. A S Alexandrov, *Phys. Rev. B* **46** (1992) 14 932.
  13. V N Zavaritsky et al., *Europhys. Lett.* **60** (2002) 127.
  14. A S Alexandrov and P E Kornilovitch, *Phys. Lett.* **82** (1999) 807.
15. A S Alexandrov, V N Zavaritsky and S Dzhumanov, *Phys. Rev. B* **69** (2004) 052505.  
 ۱۶. شعبان رضا قربانی، ابراهیم رستم آبادی، هشتمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، مشهد، بهمن (۱۳۸۵).  
 17. M Andersson, Ö Rapp and R Tellgren, *Solid State Commun.* **81** (1992) 425.  
 18. A S Alexandrov and N F Mott, *J. Supercond.* **7** (1994) 599.  
 19. A S Alexandrov, *Phys. Rev. B* **53** (1996) 2863.  
 20. P W Anderson, *Phys. Rev.* **109** (1958) 1492.  
 ۲۱. ش. ر. قربانی، مجله پژوهش فیزیک ایران، **۵**، شماره ۴، ۲۱-۲۵۰ (۱۳۸۴).  
 ۲۲. ش. ر. قربانی، مجله پژوهش فیزیک ایران، **۶**، شماره ۳، ۱۵۱-۱۴۷ (۱۳۸۵).